



深圳市泉光半导体有限公司

单向可控硅

BT169

■用途

广泛应用于各种脉冲点火器、负离子发生器、小型马达控制器、漏电保护

■特征

较低的通态压降，灵敏一致的触发特性，可靠性高。

1=K
2=G
3=A



外型



■极限值

TO-92

| 名称 | 符号 | 规范值 | 单位 | 测试条件 |
|----------|--------------|---------|----|-------------------|
| 重复峰值阻断电压 | V_{DRM} | >600 | V | $I_{DRM}=20\mu A$ |
| 反向重复峰值电压 | V_{DRM} | >600 | V | $I_{RRM}=20\mu A$ |
| 通态电流 | $I_{T(RMS)}$ | 1.0 | A | 正弦波,180度 |
| 浪涌电流 | I_{TSM} | 10 | A | 正弦波,60HZ |
| 结温 | T_j | 125 | °C | |
| 储存温度 | T_{stg} | -40~150 | °C | |

■电特性($T_a=25^\circ C$)

| 名称 | 符号 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|------------|-----------|---|------|------|----|
| 重复峰值阻断泄漏电流 | I_{DRM} | $V_D=V_{DRM}$ | ---- | 0.1 | mA |
| 通态电压 | V_{TM} | $I_T=1.0A$ | ---- | 1.7 | V |
| 门极触发电流 | I_{GT} | $V_D=12V, R=100\Omega_L$ | ---- | 120 | uA |
| 门极触发电压 | V_{GT} | $V_D=12V, R=100\Omega_L$ | | 0.9 | V |
| 门极不触发电压 | V_{GD} | $V_D=1/2 V_{DRM}$ | 0.2 | ---- | V |
| 断态电压临界上升率 | dv_D/dt | $V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=110^\circ C$ | 10 | | |

地址：广东省深圳市龙岗区龙兴路

电话：0755-82812899

网址：<http://www.qgbdt.com>

传真：0755-82812938